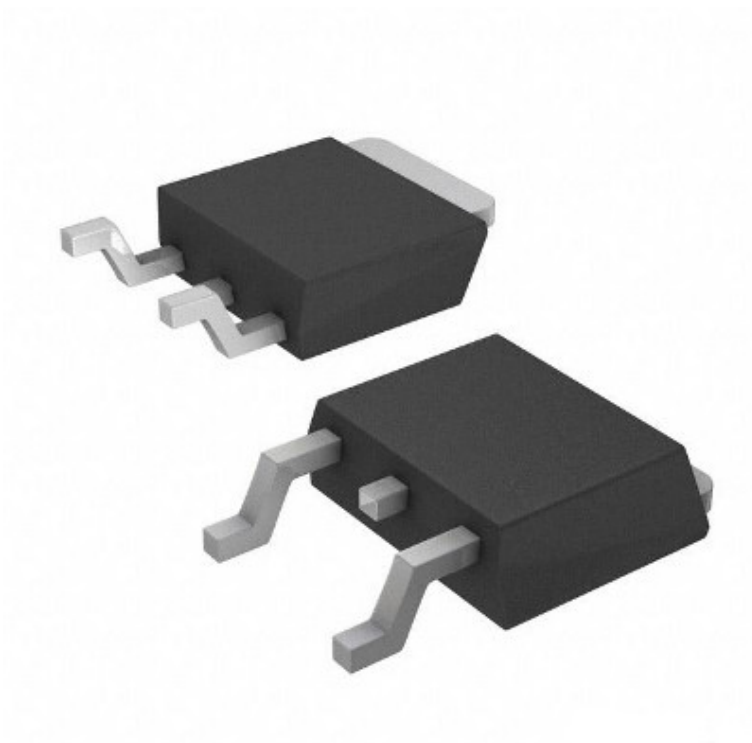


Transistor bipolaire BJT PNP -40V -3A TO-252-3



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAV2DB1182
-------	------------

Transistor bipolaire BJT PNP -40V -3A TO-252-3

Transistor bipolaire BJT PNP -40V -3A TO-252-3

Fabricant : Diodes Incorporated

Catégorie du produit : Transistors bipolaires - BJT

Style de montage : SMD/SMT

Package/Boîte : TO-252-3

Polarité du transistor : PNP

Configuration : Single

Collecteur - Tension de l'émetteur VCEO max. : - 32 V

Collecteur - Tension de base VCBO : - 40 V

Émetteur - Tension de base VEBO : - 5 V

Tension de saturation collecteur-émetteur : - 0.8 V

Courant CC max. du collecteur : - 3 A

Pd - Dissipation d'énergie : 10 W

Produit gain-bande passante fT : 110 MHz

Température de fonctionnement min. : - 55 C

Température de fonctionnement max. : + 150 C

Qualification : AEC-Q101



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Série : 2DB11

Gain de courant CC hFE max. : 270 at - 500 mA, - 3 V

Marque : Diodes Incorporated

Collecteur de courant continu/Gain hfe min de base : 120

Type de produit : BJTs - Bipolar Transistors

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles